Rīgas Tehniskā universitāte Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte Telemātikas un transporta elektronisko sistēmu katedra

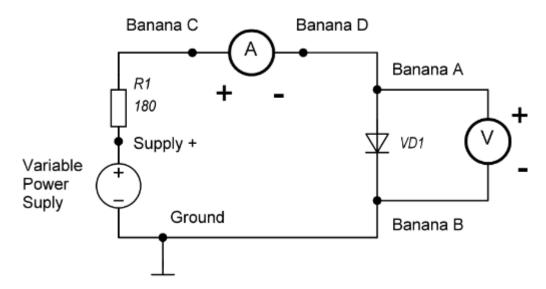
Pusvadītāju ierīces

Laboratorijas Darbs Nr 1

TAISNGRIEŽA DIODES un STABILITRONA IZPĒTE

ETF II REB C02 gr.stud. Ansis Skadiņš st.apl.Nr.151REBC02

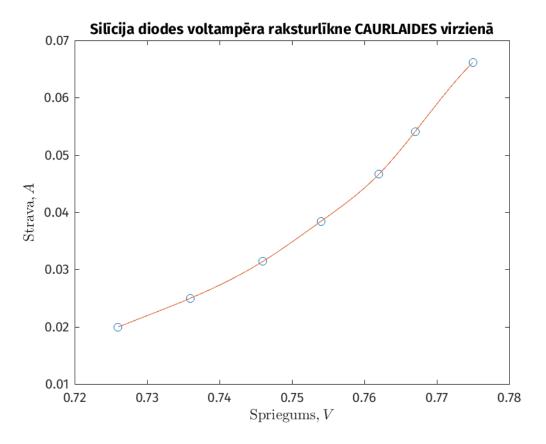
 $R\bar{i}ga - 2018$



Figūra 1: Diodes pētīšanas shēma

U_d	V	0,726	0,736	0,746	0,754	0,762	0,767	0,775
I_{tn}	mA	19,94	24,97	31,41	38,4	46,63	54,06	66,2

Tabula 1: Silīcija diodes voltamperara raksturlīknes pētīšanas rezultāti caurlaides virziena zarā



Figūra 2: Caurlaides virzienā ylim = 0.007

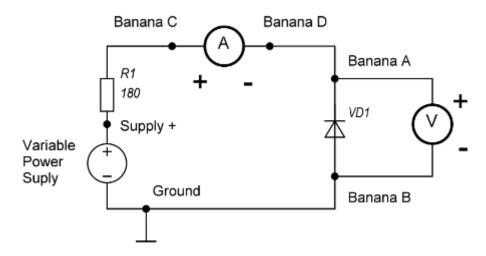
Difrenciāl
pretestības aprēķins 3 punktos

$$\sigma = \frac{dU}{dI}$$

$$\sigma_2 = \frac{dU}{dI} = 0.6590\Omega$$

$$\sigma_4 = \frac{dU}{dI} = 1.1445\Omega$$

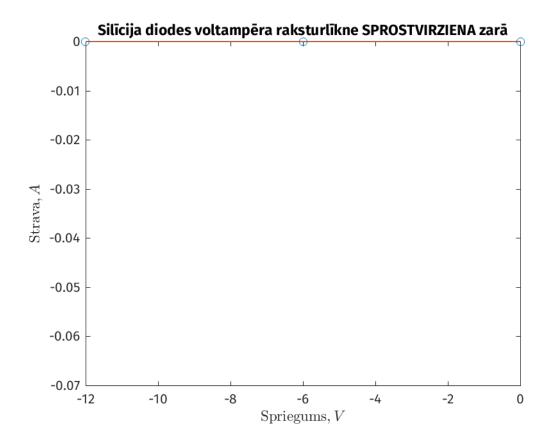
$$\sigma_7 = \frac{dU}{dI} = 1.9881\Omega$$

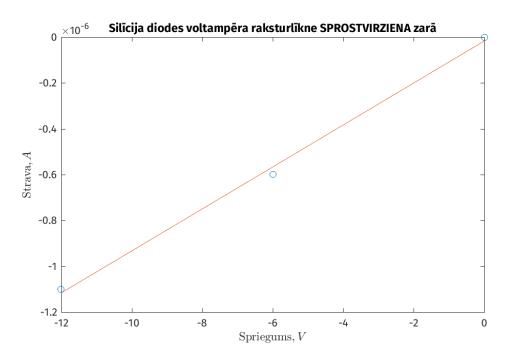


 ${\bf Fig\bar ura}$ 3: Shēma diodes pētīšanai sprostvirziena zarā

U_d	V	0	6	12
I_{spr}	μA	0	0,6	1,1

Tabula 2: Silīcija diodes voltampēra raksturlīknes pētīšanas rezultāti sprostvirziena zarā





Figūra 4: Caurlaides virzienā

Computer Name: LENOVO-PC3

User Name: Admin

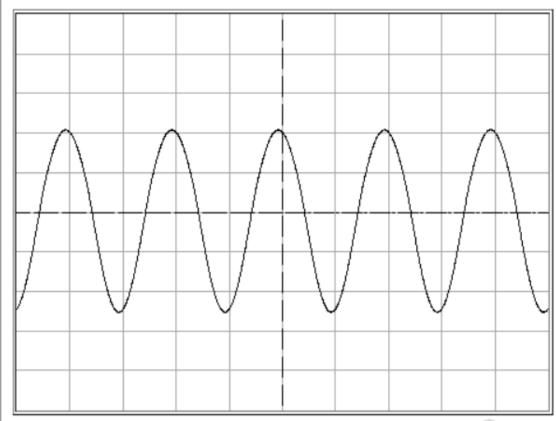
Time stamp: 10/1/2018 1:45:51 PM

CH0 Real

^^

LabVIEW

Sample Rate: 50.00 kS/s



Timeout

CH0 Meas: RMS: 1.647 V Freq: 100.025 Hz Vp-p: 4.612 V

Channel Settings	Channel 0 Values		
Source	SCOPE CH 0		
Probe	1x		
Coupling	DC		
Volts / Div (V)	1 V		
Vertical Position (Div)	0 (Div)		
Parameter	Value		
Device	Dev1 (NI ELVIS II)		
Time Base (s)	5 ms		
Trigger Type	Immediate		

Computer Name: LENOVO-PC3

User Name: Admin

Time stamp: 10/1/2018 1:47:20 PM

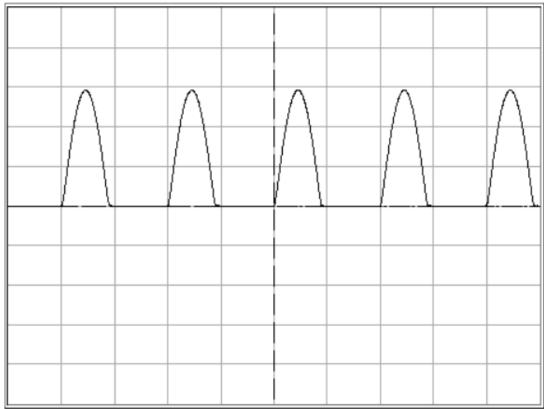
CH0 Real

CH1 Real





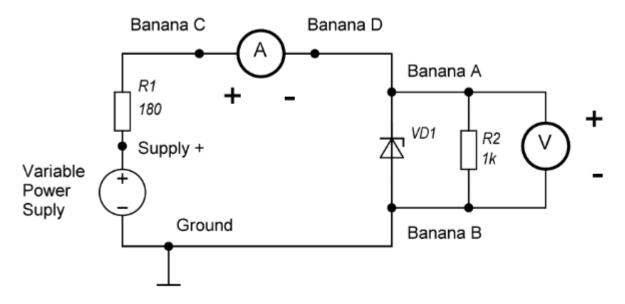
Sample Rate: 50.00 kS/s



Timeout

CH0 Meas: RMS: 680.57 mV Freq: 100.022 Hz Vp-p: 1.466 V

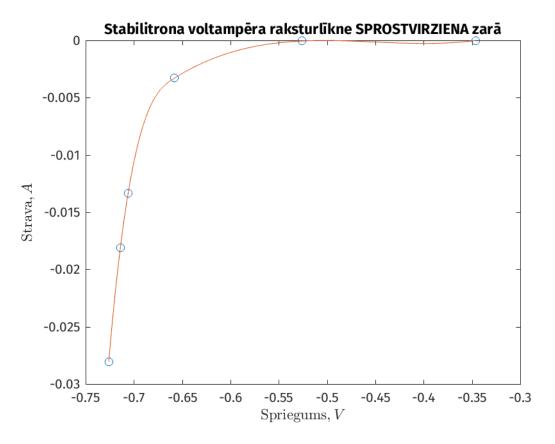
Channel Settings	Channel 0 Values		
Source	SCOPE CH 0		
Probe	1x		
Coupling	DC		
Volts / Div (V)	500 mV		
Vertical Position (Div)	0 (Div)		
Parameter	Value		
Device	Dev1 (NI ELVIS II)		
Time Base (s)	5 ms		
Trigger Type	Immediate		



 ${\bf Fig\bar ura}$ 5: Stabilitrona pētīšanas elektriskā shēma

	-	0,346	,		,		,
I_s	$_{t}$ mA	0,0012	0,0501	3,29	13,37	18,1	28,06

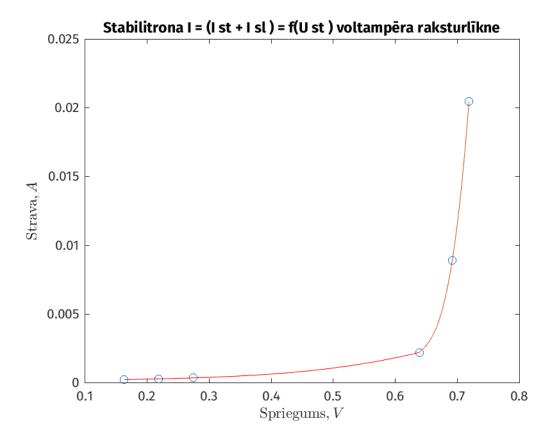
Tabula 3: Stabilitrona voltampēra raksturlīknes pētīšanas rezultāti sprostvirziena zarā



 ${f Fig\bar ura~6:~}$ Sprostvirzienā

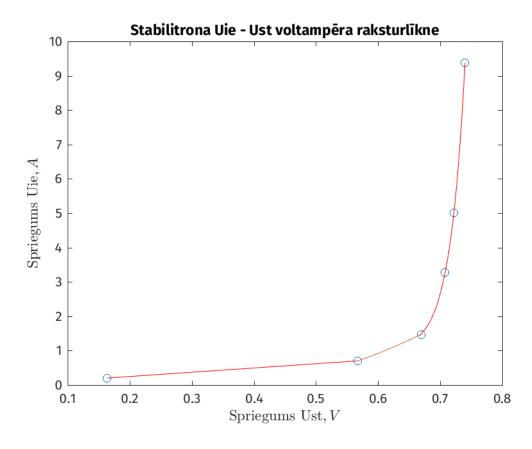
U_{st}	V	0,164	0,219	0,275	0,639	0,692	0,719
I	mA	0,2	0,26	0,33	2,18	8,87	20,45

Tabula 4: I = $(I_s t + I_s l)$ = f (U_{st}) atkarības pētīšana



	U_{st}	V	0,164	0,567	0,669	0,708	0,722	0,740
ĺ	U_{ie}	V	0,2	0,7	1,47	3,28	5	9,37

Tabula 5: $U_s t = \mathrm{f}(U_i e)$ atkarības pētīšana



Silīcija diodei darbojoties caurlaides virzienā, caurlaides strāva plūst cauri diodei. Sākoties ar nulli, raksturlīkne pakāpeniski pieaug. Kad, spriegums pārsniedz pusvadītāja kontaktpotenciālu (Silīcija diodei tas ir ap 0.7V), tādējādi veidojas izliekta raksturlīkne.

Silīcija diodei darbojoties sprostvirzienā, diode cauri laiž ļoti mazu strāvu (10⁻⁶). Tā tas turpinās līdz spriegums sasniedz caursites spriegumu. Diodei ilgi strādājot caursites režīmā, tā tiek bojāta. Šo efektu izmanto taisngrieži, lai maiņstrāvu pārveidotu līdzstrāvā.

Difrencīalpretestība norāda, ka diodes volt-ampēra raksturlīkne nav lineāra. Stabilitrona caursites spriegums ir pietiekami mazs, lai tas netiktu bojāts, to izmantojot sprostvirzienā.

$$I_{diode} = \frac{U_{ie} - Uizejas}{R}$$

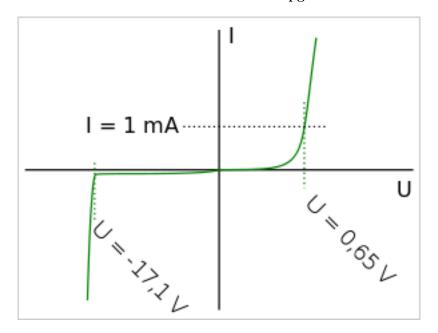
Sprieguma R vērtība, ļauj kontrolēt vēlamo strāvu.

Jautājumi

Kas ir divu pusvadītāju potenciāla starpība un kādās mērvienībās tas tiek novērtēts? Aizliegtā zona. Kuloni (C)

Kādas ir pusvadītāja diožu pielietošanas sfēras?

Strāvas pārveidošana, tuneļdiodes augstu frekvenču ģeneratoros, saules baterijās, LEDs. Uzzīmējiet stabilitrona voltampēru raksturlīkni. Paskaidrojiet, kādi fiziski procesi ietekmē raksturlīknes formu dažādos apgabalos.



Galvenie stabilitrona parametri un to skaitliskās vērtības. Darbības spriegums, temperatūras koeficents. Sakarība nav lineāra. Paskaidrot sprieguma stabilizācijas principu ar stabilitrona palīdzību. Stabilatrons nodrošina stabilu izejas spriegumu. Paralēli maiņstrāvas sprieguma avotam sprostvirzienā, stabilitrons vada strāvu, kad tiek sasniegts caursites spriegums. Rezistors paralēli, ļauj kontrolēt strāvas stiprumu.

$$I_{diode} = \frac{U_{ie} - Uizejas}{R}$$

 $\textbf{Varikapi, to pielietošanas sf\bar{e}ras.} \ \text{Sprieguma kontrol\bar{e}ts kondensators.} \ \text{Oscilatoros, FM modul\bar{a}cij\bar{a}}.$